

ПРОТОКОЛ № 18/2018
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного автономного научного учреждения
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

28 сентября 2018 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А.Гамкрелидзе
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин
Члены комиссии:	- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В. Колковский - член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН В.Ф. Лукичев - доктор технических наук, профессор, зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского С.Б. Нестеров

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня: Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малощумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

Слушали:

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Павлова Владимира Юрьевича для избрания его на должность научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малощумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе». Директор зачитал характеристику Павлова В.Ю., подписанную заведующим лабораторией №106 Павловым А.Ю. В ней, в частности отмечается, что Павлов В.Ю. является специалистом в области технологии формирования полевых гетероструктурных сверхвысокочастотных транзисторов и схем на их основе. Им выполнялись исследования

по оптимизации технологии формирования контакта металл-полупроводник (нитрид галлия, арсенид галлия), о чем свидетельствуют три патента на изобретение, а также проводилась оптимизация технологии золочения гальваническим методом для изготовления МИС СВЧ.

Павлов В. Ю. является соавтором 8 статей в ведущих отечественных научных журналах. Результаты исследований неоднократно представлялись на отечественных и международных научных конференциях и семинарах. В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН он проявил себя как квалифицированный специалист в области технологии полупроводниковых приборов на полупроводниках группы АЗВ5.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

2. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило резюме для прохождения конкурса от Пименовой Светланы Семеновны 1993 г.р. для избрания по конкурсу на должность научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

Однако документы претендента не удовлетворяют квалификационным характеристикам, предъявляемым по соответствующей должности, а также в комиссию представлен не полный пакет документов, в связи с этим членами Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию претендента Пименовой С.С.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе» состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании балльной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

– Павлова Владимира Юрьевича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор
Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.

«28» сентября 2018 г.



С.А. Гамкрелидзе

Р.А. Хабибуллин